^{08,11} Структурный переход в галлате лантана и трансформация тонкой структуры ЭПР примесного Gd³⁺-центра

© В.А. Важенин, В.Б. Гусева, А.В. Фокин, А.П. Потапов, М.Ю. Артёмов

Уральский государственный университет, Екатеринбург, Россия

E-mail: vladimir.vazhenin@usu.ru

(Поступила в Редакцию 8 июля 2010 г.)

В результате измерений температурного поведения спектров ЭПР центров Gd^{3+} и Mn^{4+} в окрестности структурного превращения галлата лантана обнаружены скачкообразное изменение резонансных положений, температурный гистерезис и сосуществование фаз, свидетельствующие о переходе первого рода. Трансформация моноклинных центров Gd^{3+} в тригональные при фазовом превращении использована для оценки адекватности двух аппроксимаций суперпозиционной модели для параметров начального расщепления основного состояния.

1. В результате экспериментов по рассеянию рентгеновских лучей [1-4] и нейтронов [5-7] на порошковых образцах и монокристаллах LaGaO3 было установлено существование при 420-430 К структурного перехода $P_{bnm}(D_{2h}^{16}) \leftrightarrow R\bar{3}c(D_{3d}^6)$ между фазами, имеющими структуру искаженного перовскита. Указанный переход в монокристаллах галлата лантана, слаболегированного марганцем и содержащего некотролируемые примеси гадолиния и железа, был зарегистрирован и методом парамагнитного резонанса [8,9]. Увеличение концентрации марганца приводило к заметному повышению температуры фазового перехода. Авторы [8,9] исследовали спектр ЭПР ионов Gd³⁺, замещающих La³⁺, и ионов Mn⁴⁺, Fe³⁺, Mn²⁺, локализованных в позиции Ga³⁺. В обоих фазах были определены параметры спинового гамильтониана центра Gd^{3+} , группа симметрии которого меняется от $m(C_s)$ до $32(D_3)$, а также Mn^{4+} ($\overline{1}(C_i) \rightarrow \overline{3}(S_6)$). Настоящая работа посвящена ЭПР-исследованию особенностей структурного перехода в галлате лантана.

Общеизвестно, что спектр парамагнитного резонанса высокоспинового центра содержит уникальную информацию о строении локального окружения дефекта, которое, очевидно, отличается от структуры бездефектного кристалла. Проблема извлечения структурной информации из спектра, состоящая в нахождении связи между спектральными параметрами и параметрами локального окружения, может быть решена путем построения адекватной микроскопической теории; однако данный подход наталкивается на большие трудности [10-12]. В связи с этим понятно большое количество работ, посвященных попыткам связать параметры начального расщепления высокоспинового парамагнитного центра с координатами лигандного окружения посредством эмпирических соотношений. Наиболее известным вариантом такой связи является суперпозиционное приближение, предполагающее аддитивность вкладов в параметры тонкой структуры *b_{nm}* [13,14] от ближайших анионов. В настоящей работе трансформация парамагнитных центров в результате структурного перехода в галлате лантана используется для апробирования указанного подхода.

2. Измерения проводились на спектрометре ЭПР трехсантиметрового диапазона EMX Plus фирмы Bruker. Погрешность измерения температуры составляла ± 1 К. Исследовались монокристаллы LaGaO₃ с примесью марганца (концентрация диоксида марганца в шихте 0.5 и 5.0 mol.%, чистота используемых химикатов не хуже 99.99%), выращенные Лутцем в Университете Норфолка (Вирджиния, США) методом Чохральского в слабо окислительной атмосфере.

3. Температурная трансформация ЭПР-спектра образца с примесью 0.5 mol.% марганца в окрестности структурного перехода при нагревании и **B** || **y** || **c**, где **B** — индукция магнитного поля, **c** — кристаллографическая ось в группе $P_{bnm}(D_{2h}^{16})$, **y** — магнитная ось в низкотемпературной фазе (разориентация от **B** || **y** составляет $\approx 3^{\circ}$), приведена на рис. 1. Хорошо видно, что при 450 К наблюдается сосуществование фаз.

На рис. 2 показаны спектры, полученные на том же образце при его охлаждении. Идентификация переходов центров Gd^{3+} приведена на рис. 1, а Mn^{4+} на рис. 2. Сравнение рис. 1 со спектрами на рис. 2, полученными при охлаждении (сосуществование фаз при 447 К), приводит к заключению о наличии температурного гистерезиса (≈ 3 K). Сигналы перехода 1–2 иона Mn⁴⁺ в ромбоэдрической фазе (рис. 3) не наблюдаются, так как их интенсивность составляет $\approx 1/20$ интенсивности компонент перехода 3-4. Неидентифицированные сигналы на рис. 1,2 (например, сигнал высокотемпературной фазы, стоящий ниже шестерки сверхтонких переходов Mn⁴⁺) обусловлены в основном переходами в альтернативных сегнетоэластических доменах. Радикально скачкообразное изменение положений ЭПР-сигналов Gd^{3+} (рис. 1,4), Mn^{4+} (рис. 2) в сочетании с наличием температурного гистерезиса и сосуществованием фаз убедительно свидетельствует о структурном переходе первого рода. Постоянство резонансных положений переходов в обеих фазах, за исключением точки структур-



Рис. 1. Зависимость вида ЭПР-спектра (производной спектра поглощения) галлата лантана (0.5 mol.% Mn) от температуры в ориентации, близкой к **B** || **y** || **c**, при нагревании. Около интенсивных сигналов центра Gd^{3+} в двух фазах приведены номера уровней, между которыми происходят переходы. Уровни Gd^{3+} пронумерованы в порядке возрастания энергии.



Рис. 2. Зависимость вида ЭПР-спектра галлата лантана от температуры в ориентации, близкой к **B** \parallel **y** \parallel **c**, при охлаждении. Около групп сигналов, обусловленных сверхтонкой структурой центра Mn^{4+} , приведены номера электронных уровней (рис. 5 в [9]), между которыми происходят переходы в двух фазах.



Рис. 3. Расчетная сверхтонкая структура электронных переходов 3–4 и 2–3 центров Mn^{4+} при ориентации, близкой к **В** || **y** || **c**, в ромбоэдрической фазе.



Рис. 4. Температурное поведение положений переходов 5–6 (сплошная линия) и 6–7 (штриховая) иона Gd³⁺ в окрестности структурного превращения.

ного превращения (рис. 4), свидетельствует о слабой зависимости параметров тонкой структуры от температуры. Колоссальное изменение параметров спинового гамильтониана второго ранга, включая смену знака b_{20} центров Mn^{4+} (табл. 1), почти полностью происходит при температуре структурного перехода.

Кроме обсуждаемых узких сигналов в ЭПР-спектре присутствует интенсивная и широкая линия, слабо зависящая от ориентации магнитного поля. Кристаллы с примесью 5 mol.% марганца демонстрируют уже несколько таких линий (рис. 1 в [9]), обусловленных, скорее всего, кластерами ионов марганца. Заметного отклика параметров этих линий на структурный переход нами не обнаружено.

В орторомбической фазе при $\mathbf{B} \parallel \mathbf{y}$ два магнитнонеэквивалентных центра Gd^{3+} вырождаются. Во избе-

Таблица 1. Параметры второго ранга (в MHz) спиновых гамилтонианов центров Gd^{3+} и Mn^{4+} в двух фазах галлата лантана в системе координат низкотемпературной фазы

Параметр	Gd^{3+}		Mn ⁴⁺	
	300 K	438 K	300 K	438 K
b_{20}	-2276	-1772	3556	-3100
b_{21}	± 4278	0	950	0
b_{22}	-91	1772	-1650	3100
C 21	0	-10023	3900	-17535
c 22	0	0	-1730	0

Примечание. Два знака у b_{21} центра Gd³⁺ соответствуют двум магнитно-неэквивалентным центрам, спиновые гамильтонианы четырех центров Mn⁴⁺ при комнатной температуре получаются путем изменения знаков параметров согласно табл. 2 в [9].

жание ошибки в определении ширины линии за счет расщепления сигналов от вырожденных центров изза некотролируемой разориентации измерения проводились в ориентации, отстоящей от **B** || **y** на 12°. Два интенсивных сигнала на рис. 5 являются переходами 5–6 (рис. 1) двух неэквивалентных центров Gd³⁺. В пределах погрешности измерений нами не было замечено температурной зависимости ширины линий центров Gd³⁺ в обеих фазах (рис. 1 и 5). Ширина между пиками первой производной линии поглощения ΔB_{pp} оставалась ≈ 1 mT, форма линии была промежуточной между гауссианом и лоренцианом.

Аналогичное поведение ЭПР-спектров кубических и тетрагональных (в парафазе) центров Gd³⁺ (скачкообразное изменение резонансных положений, сосуществование спектров соседних фаз и отсутствие уширения



Рис. 5. Температурная зависимость спектра Gd^{3+} при нагревании в ориентации, отстоящей от **B** \parallel **y** \parallel **c** на 12°.

линий в окрестности перехода) наблюдалось в трихлориде цезия стронция CsSrCl₃, испытывающем последовательность сегнетоэластических переходов первого рода $O_h^1 \leftrightarrow D_{4h}^5 \leftrightarrow D_{2h}^{17} \leftrightarrow C_{2h}^2$ при температурах 390, 379, 366 К [15,16], в результате конденсации компонент ротационных мод M_3 и R_{25} [17].

В случае сегнетоэластического перехода (453 K) первого рода $R\bar{3}m(D_{3d}^5) \leftrightarrow C2/c(C_{2h}^6)$ в монокристалле Pb₃(PO₄)₂ на центрах Gd³⁺ и Mn²⁺ обнаружено сильное уширение ЭПР-сигналов [18], которое авторы связывают с влиянием критических флуктуаций параметра порядка на спин-решеточную релаксацию. Однако следует отметить, что, судя по температурному поведению как параметров спинового гамильтониана, так и резонансных положений [19], фазовое превращение в этом кристалле необходимо считать близким ко второму роду.

На наш взгляд, механизм уширения линий ЭПР, обусловленный замедлением флуктуаций параметра порядка или его модуляций в результате аномального взаимодействия с дефектами в мягкой решетке [20], оказывается неэффективным в случае структурных переходов первого рода ввиду отсутствия спиновых (спектральных) состояний, промежуточных между состояниями, характерными для соседствующих фаз. Именно такая ситуация реализуется в кристаллах галлата лантана и трихлорида цезия стронция.

4. Наиболее известная аппроксимация суперпозиционного приближения для констант тонкой структуры основного состояния, предложенная Ньюмэном, содержит два внутренних параметра ($\bar{b}_n(R_0)$ и t_n) [13,14]:

$$b_{nm} = \sum_{d} K_{nm}(\theta_d, \varphi_d) \bar{b}_n(R_d), \qquad (1)$$

$$\bar{b}_n(R_d) = \bar{b}_n(R_0)(R_0/R_d)^{t_n},$$
 (2)

где $K_{nm}(\theta_d, \varphi_d)$ — угловой структурный фактор, R_d , θ_d , φ_d — сферические координаты лигандов, R_0 сумма ионных радиусов лиганда и центрального иона. Несмотря на то что внутренние параметры демонстрируют постоянство лишь для парамагнитных центров в рядах изоструктурных кристаллов, авторами десятков публикаций этот формализм использован для анализа экспериментальных параметров начального расщепления *d*- и *f*-ионов как второго, так и четвертого ранга.

В работе Левина [21] обоснована возможность использования суперпозиционного приближения для параметров тензора тонкой структуры второго ранга редкоземельных ионов в *S*-состоянии и предложена иная версия выражения (2)

$$\bar{b}_2(R_d) = \bar{b}_{2p}(R_0)(R_0/R_d)^3 + \bar{b}_{2s}(R_0)(R_0/R_d)^k.$$
 (3)

Первый член отвечает за вклад электростатического поля точечного заряда лиганда, второй — близкодействующего взаимодействия металл–лиганд, $k \approx 10$. Это выражение, как и (2), содержит два внутренних параметра: $\bar{b}_{2p}(R_0)$ и $\bar{b}_{2s}(R_0)$.

Трансформация центров Gd³⁺ при структурном превращении из моноклинных в тригональные делает галлат лантана модельным объектом для сравнения эффективности и адекватности приведенных выше аппроксимаций суперпозиционного приближения.

5. Авторами [8] для параметров тонкой структуры второго ранга центров Gd^{3+} в LaGaO₃ при комнатной температуре в системе координат **x** || **a**, **y** || **c**, **z** || **b** (**a**, **b**, **c** — оси в группе $P_{bnm}(D_{2h}^{16})$) получены значения, приведенные в табл. 1. С учетом координат двенадцатикратного кислородного окружения иона лантана, следующих из структурных данных [7], с помощью (1), (3) были получены выражения для параметров (при $R_0 = 234 \,\mathrm{pm}$): $b_{20} = -0.058\bar{b}_{2p} - 0.19\bar{b}_{2s}$, $b_{21} = 0.262\bar{b}_{2p} + 0.8\bar{b}_{2s}$, $b_{22} = 0.296\bar{b}_{2p} + 0.525\bar{b}_{2s}$.

Приравнивание этих выражений к экспериментальным значениям дает избыточную систему уравнений для двух внутренних параметров. В методе наименьших квадратов наилучшее согласие результатов этих выражений ($b_{20} = -1169 \text{ MHz}$, $b_{21} = 4561 \text{ MHz}$, $b_{22} = -123 \text{ MHz}$, среднеквадратичное отклонение S = 816 MHz) с экспериментальными значениями было достигнуто при следующих внутренних параметрах (табл. 2): $\bar{b}_{2p} = -25000 \text{ MHz}$, $\bar{b}_{2s} = 13850 \text{ MHz}$.

Несовместность системы уравнений для \bar{b}_{2p} и \bar{b}_{2s} может быть обусловлена отличием окружения парамагнитного иона от структуры чистого кристалла [7] в результате релаксации решетки. Из-за существенного различия радиусов примесного и замещаемого ионов (в девятикратном окружении $R(\text{Gd}^{3+}) = 110.7$, $R(\text{Ln}^{3+}) = 121.6 \text{ pm } [22]$) логично предположить существование наряду с другими искажениями полносимметричной деформации окружения парамагнитного дефекта. В соответствии с [23] для учета такой деформации в выражении (3) в качестве R_d были использованы \bar{R}_d :

$$\bar{R}_d = R_d - \Delta R, \quad \Delta R = 1/2 \{ R(\text{Ln}^{3+}) - R(\text{Gd}^{3+}) \}.$$
 (4)

В результате среднеквадратичное отклонение уменьшилось, а внутренние параметры приняли значения $\bar{b}_{2p} = -25\,110\,\text{MHz}, \, \bar{b}_{2s} = 12\,000\,\text{MHz}.$

Подстановка последних внутренних параметров в выражения (1), (3) с координатами лигандного окружения высокотемпературной фазы [7], деформированного согласно (4), дает значение b_{20} (табл. 2) более близкое к экспериментальному, чем без учета деформации. Следует отметить, что автор работы [21] для центров Gd³⁺ в кислородном окружении и $R_0 = 234$ pm указывает значения \bar{b}_{2p} и \bar{b}_{2s} , которые по порядку величины и знакам согласуются с полученными нами, а их использование в высокотемпературной фазе LaGaO₃ приводит к разумному (по порядку величины и знаку) параметру b_{20} (табл. 2).

С целью более полного учета релаксации решетки нами была предпринята попытка расчета структуры примесного кристалла с помощью программы GULP 3.4 (автор Gale) в приближении парных ионных взаимодействий [24–26] и оболочечной модели, позволяющей

Таблица 2. Внутренние параметры $\bar{b}_{2p}(R_0)$, $\bar{b}_{2s}(R_0)$, среднеквадратичные отклонения *S* и предсказываемые для центров Gd^{3+} ромбоэдрической фазы значения b_{20} ($\mathbf{z} \parallel \mathbf{C}_3$) в аппроксимации Левина (3) (все величины в MHz)

$ar{b}_{2p}(R_0)$	$ar{b}_{2s}(R_0)$	S	b_{20}	Структура окружения
-25000	13850	816	-1190	[7]
-25110	12000	750	-1260	[7] + релаксация
-12905 [21]	6897 [21]	_	-1050	согласно (4) [7] + релаксация согласно (4)
—	—	—	-3544	Эксперимент [8]

Таблица 3. Внутренние параметры $\bar{b}_2(R_0)$ и t_2 , а также среднеквадратичные отклонения *S* и предсказываемые для центров Gd³⁺ ромбоэдрической фазы LaGaO₃ значения b_{20} ($\mathbf{z} \parallel \mathbf{C}_3$) в аппроксимации Ньюмэна (2) ($\bar{b}_2(R_0)$, *S* и b_{20} приведены в MHz)

$\bar{b}_2(R_0)$	<i>t</i> ₂	S	b_{20}	Источник
3590	7.7	2010	-1670	Первый вариант,
-2540	-1	1710	340	Второй вариант, настоящая работа
-6000	0.4	_	_	CaO [14]
-6000	0.8	_	-	SrO [14]
-3000	1	—	—	YVO ₄ [14]

учесть поляризацию решетки. Предсказание этим расчетом сильных искажений, как угловых, так и радиальных, на порядок превышающих величины в (4), кардинально меняют коэффициенты избыточной системы уравнений и приводит к решениям с большими среднеквадратичными отклонениями. Кроме того, было обнаружено, что структура беспримесного кристалла воспроизводится с погрешностью, значительно превышающей ошибки нейтронных экспериментов [7]. Указанные факты заставили нас отказаться от использования полученных результатов.

Нами были проведены вычисления и в рамках версии суперпозиционного приближения Ньюмэна (2) с использованием релаксированного согласно (4) кислородного окружения. Результаты суммированы в табл. 3, где также приведены величины внутренних параметров для центров Gd^{3+} в оксидах из работы [14]. В орторомбической фазе при решении системы уравнений получены два варианта параметров, демонстрирующих практически одинаковое значение среднеквадратичного отклонения *S*, в связи с чем возникает вопрос выбора физически оправданного решения. Следует заметить, что полученые здесь значения *S*, характеризующие качество выполнения уравнений, заметно превышают среднеквадратичные отклонения табл. 2, что свидетельствует о больших погрешностях в значениях внутренних параметров.

Внутренние параметры первого варианта с учетом указанных погрешностей можно считать близкими к величинам, полученным авторами [14] для центров в CaO, SrO и YVO₄. Однако использование этих параметров в ромбоэдрической фазе дает для b_{20} весьма далекое от эксперимента значение (табл. 3). Второй вариант предсказывает для центра Gd³⁺ в высокотемпературной фазе значение b_{20} , по знаку и порядку согласующееся с экспериментальным (табл. 3), но внутренние параметры не имеют ничего общего с величинами, характерными для Gd³⁺ в оксидных кристаллах [14].

6. Полученные в разделе 5 внутренние параметры модели были нами использованы для предсказаний начальных расщеплений центров Gd^{3+} в перовскитоподобных соединениях BaTiO₃ ($P4mm(C_{4v}^1)$ [27]) и LaAlO₃ ($R\bar{3}c(D_{3d}^6)$ [28]), реализующихся в результате структурных переходов из фазы O_h^1 . В BaTiO₃ ион Gd³⁺ занимает позицию иона бария (C_{4v}), а в LaAlO₃ — иона лантана (D_3). Величины параметров начальных расщеплений b_{20} для центров гадолиния в этих кристаллах определены авторами [29,30]. Результаты этих предсказаний, учитывающих полносимметричную релаксацию окружения согласно (4), и экспериментальные значения приведены в табл. 4.

Как видно, для BaTiO₃ суперпозиционная модель в аппроксимации Левина (3) дает результат, близкий к экпериментальному (предсказываются знак и порядок величины b_{20}), тогда как согласие предсказаний двух вариантов аппроксимации Ньюмэна (2) с опытом заметно хуже. Расчеты b_{20} для LaAlO₃:Gd³⁺ во всех случаях дают существенно отличные от эксперимента результаты.

Для разрешения этой ситуации вслед за авторами работы [23] попытаемся учесть релаксацию в LaAlO₃ угловых координат ближайшего окружения центра гадолиния. Аналогичную процедуру имеет смысл провести

Таблица 4. Расчетные и экспериментальные значения параметров начальных расщеплений центров Gd^{3+} (ΔR — величина радиальной релаксации окружения)

Кристалл	Аппроксимация	ΔR , pm	<i>b</i> ₂₀ , MHz	
			Расчет	Эксперимент
BaTiO₃	Левин Ньюмэн, первый варинат Ньюмэн, второй варинат	10	-630 -15 -240	-878 [29]
LaAlO ₃	Левин Ньюмэн, первый варинат Ньюмэн, второй варинат	5	-480 -410 70	1113 [30]

Таблица 5. Величины релаксации угловых координат лигандного окружения центров Gd³⁺, необходимые для согласия с экспериментом

Кристалл	Аппроксимация	$\Delta \theta_2$, deg
LaAlO ₃	Левин	0.8
	Ньюмэн,	-7
	первый вариант	
	Ньюмэн,	2
	второй вариант	
LaGaO ₃	Левин	-1.2
	Ньюмэн,	11
	первый вариант	
	Ньюмэн,	-10
	второй вариант	

и для ромбоэдрической фазы LaGaO₃, где предсказания величины начального расщепления весьма приблизительны (см. раздел 5). Двенадцатикратное кислородное окружение La³⁺ в этих соединениях (точечная группа D_3) состоит из шестиугольника ионов с $\theta_1 = 90^\circ$ и двух кислородных треугольников с $\theta_2 \approx 35^\circ$, $\theta_3 = (180-\theta_2)^\circ$ (где θ — полярный угол). Оставаясь в указанной точечной группе, можно варьировать лишь параметры θ_2 — угол между C_3 и осью связи гадолиний–ион в кислородном треугольнике.

Оказалось, что в рамках аппроксимации Левина (3) путем небольших ($\approx 1^{\circ}$) угловых искажений можно получить идеальное согласие с экспериментом (табл. 5).

В случае двух вариантов версии Ньюмэна (2) аналогичного результата удается достичь, предполагая на порядок большие и, скорее всего, нереалистичные искажения.

Последние оценки, полученные в аппроксимации Левина (3), по-видимому, преждевременно считать надежной информацией о характере и величине искажений кристаллического окружения при замене иона. Приведенные в табл. 5 величины могут быть и результатом погрешностей во внутренних параметрах модели. Тем не менее можно уверенно утверждать, что версия суперпозиционной модели Левина (3) заметно лучше, чем версия Ньюмэна (2), описывает начальные расщепления иона гадолиния в перовскитоподобных кристаллах.

Авторы благодарны Г.Б. Лутцу и В.А. Ацаркину за предоставленные монокристаллы галлата лантана.

Список литературы

- [1] S. Geller. Acta Cryst. 10, 243 (1957).
- [2] А.Н. Морозов, О.Ю. Морозова, Н.М. Пономарев, Н.Н. Степарева, В.С. Куцев, О.А. Бузанов. Кристаллография 38, 165 (1993).
- [3] S.B. Ubizskii, L.O. Vasylechko, D.I. Savytskii, A.O. Matkovskii, I.M. Syvorotka. Supercond. Sci. Technol. 7, 766 772 (1994).

- [4] M.L. Sanjuan, V.M. Orera, R.I. Merino, J. Blasco. J. Phys.: Cond. Matter 10, 11687 (1998).
- [5] W. Marti, P. Fischer, F. Altorfer, H.J. Scheel, M. Tadin. J. Phys.: Cond. Mateer 6, 127 (1994).
- [6] W. Marti, P. Fischer, J. Schefer, F. Kubel. Z. Kristallogr. 211, 891 (1996).
- [7] C.J. Howard, B.J. Kennedy. J. Phys.: Cond. Matter 11, 3229 (1999).
- [8] В.А. Важенин, А.П. Потапов, В.Б. Гусева, М.Ю. Артемов. ФТТ 51, 869 (2009).
- [9] В.А. Важенин, А.П. Потапов, В.Б. Гусева, М.Ю. Артемов. ФТТ 52, 480 (2010).
- [10] B.G. Wybourne. Phys. Rev. 148, 1, 317 (1966).
- [11] Э.Х. Ивойлова, А.А. Корниенко, А.М. Леушин. ФТТ 20, 1403 (1978).
- [12] M.V. Eremin, I.I. Antonova. J. Phys.: Cond. Matter 10, 5567 (1998).
- [13] D.J. Newman, W. Urban. Adv. Phys. 24, 793 (1975).
- [14] Crystal Field Handbook / Eds D.J. Newman, B. Ng. Cambridge University Press, Cambridge (2000). P. 151.
- [15] В.А. Важенин, М.Ю. Артемов. ФТТ 39, 370 (1997).
- [16] В.А. Важенин, В.Б. Гусева, М.Ю. Артемов. ФТТ 41, 247 (1999).
- [17] К.С. Александров, А.Т. Анистратов, Б.В. Безносиков, Н.В. Федосеева. Фазовые переходы в кристаллах галоидных соединений ABX₃. Наука, Новосибирск (1981). 266 с.
- [18] M. Razeghi. Phys. Status Solidi B 108, 175 (1981).
- [19] Yong Nam Choi, Sung Ho Choh, Min Su Jang. J. Korean Phys. Soc. (Proc. Suppl.) 29, S 486 (1996).
- [20] G.F. Reiter, W. Berlinger, K.A. Müller, P. Heller. Phys. Rev. B 21, 1 (1980).
- [21] L.I. Levin. Phys. Status Solidi B 134, 275 (1986).
- [22] R.D. Shannon. Acta Cryst. A 32, 751 (1976).
- [23] Shao-Yi Wu, Hua-Ming Zhang, Guang-Duo Lu, Zhi-Hong Zhang. Pramana — J. Phys. 69, 451 (2007).
- [24] A. Senyshyn, H. Ehrenberg, L. Vasylechko, J.D. Gale, U. Bismayer. J. Phys.: Cond. Matter 17, 6217 (2005).
- [25] M.S. Khan, M.S. Islam, D.R. Bates. J. Phys. Chem. B 102, 3099 (1998).
- [26] M.R. Levy, R.W. Grimesy, K.E. Sicafus. Phil. Mag. 84, 533 (2004).
- [27] Ф. Иона, Д. Ширане. Сегнетоэлектрические кристаллы. Мир, М. (1965). 556 с.
- [28] B.C. Chakoumakos, D.G. Schlom, M. Urbanik, J. Luine. J. Appl. Phys. 83, 1979 (1998).
- [29] L. Rimai, G.A. de Mars. Phys. Rev. 127, 702 (1962).
- [30] W. Low, A. Zusman. Phys. Rev. 130, 144 (1963).